

## شناسایی خواص تشدیدگرهای دیالکتریک با استفاده از روش انگرال کانتور چندمدى

سید علی هاشمی<sup>(۱)</sup> - علی بنایی<sup>(۲)</sup>

(۱) استادیار - گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی  
 (۲) دانشیار - دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ دریافت: پاییز ۱۳۸۸ | تاریخ پذیرش: زمستان ۱۳۸۹

**خلاصه:** روش انگرال کانتور چندمدى یکی از روش‌های تحلیل و طراحی مدارهای موجبری صفحه H است. این روش تأثیر مدهای مرتبه بالاتر غیرانتشاری را که به دلیل وجود ناپیوستگی در ساختار موجبری ایجاد شده و در نزدیکی ناپیوستگی انرژی قابل ملاحظه‌ای دارد، در نظر می‌گیرد. این ویژگی موجب بالا رفتن دقت روش در تحلیل و یا طراحی مدارهای موجبری با ساختار پیچیده می‌شود. در این مقاله قصد داریم از توانمندی این روش در شناسایی خواص تشدیدگرهای دیالکتریک مانند فرکانس تشدید و ثابت دیالکتریک استفاده کنیم تا طراحی فیلترهای DR با دقت بالاتری انجام گرفته و نیاز به بهینه‌سازی و تنظیمات نهایی فیلتر را به حداقل برساند. مقایسه نتایج روش پیشنهادی با نتایج حاصل از سایر روش‌ها، دقت روش پیشنهادی را ارزیابی خواهد کرد.

**کلمات کلیدی:** روش انگرال کانتور چندمدى، ناپیوستگی صفحه H، تشدیدگر دیالکتریک، ماتریس پراکندگی

این مقاله قصد داریم از روش انگرال کانتور چندمدى در شناسایی ویژگیهای تشدیدگرهای دیالکتریک استفاده کنیم. لذا در ادامه و در بخش (۲) روش انگرال کانتور را اجمالاً معرفی می‌کنیم. در بخش (۳) نحوه تحلیل محیط‌های چندگانه، مانند موجبرهای حاوی تیرکهای دیالکتریک، با روش انگرال کانتور چندمدى را ارائه می‌کنیم. در بخش (۴) مثالهایی در این خصوص ارائه و نتایج کسب شده با سایر روش‌ها مقایسه می‌شوند. نهایتاً در بخش (۵) به جمع‌بندی مطالب خواهیم پرداخت.

### ۲- روش انگرال کانتور

روش انگرال کانتور یکی از روش‌های تحلیل مدارهای صفحه ای است. در این روش ولتاژ RF در نقطه دلخواه s<sub>0</sub> روی مرز پیرامون مدار، C، توسط معادله (۱) داده می‌شود [۷]:

$$V(s_0) = \frac{1}{j4} \oint_C \{ k \cos\theta H_1^{(2)}(kr) V(s) - j\omega \mu b H_0^{(2)}(kr) J(kr) \} ds \quad (1)$$

۱- مقدمه کاربرد مواد دیالکتریک در فرکانس‌های رادیویی برای اولین بار توسط رایلی در سال ۱۸۹۷ مطرح شد [۱]. یک تشدیدگر دیالکتریک (DR)، قطعه‌ای از عناصر عایق با ثابت دیالکتریک بالا است که در شکل‌های مختلفی مانند استوانه، مکعب، و غیره ساخته می‌شود. ویژگی بارز DRها، بالا بودن ضریب کیفیت (Q) و پایداری حرارتی آنهاست. اکنون دیالکتریک‌هایی با تلفات بسیار کم در دسترسند که قادرند ضریب کیفیت 50000 یا حتی بیشتر فراهم نمایند. از تشدیدگرهای دیالکتریک در ساخت فیلترهای موجبری استفاده می‌شود [۲ و ۳]. بنابراین لازم است فرکانس تشدید و ثابت دیالکتریک آنها با دقت بالایی شناسایی گردد تا فیلتر طراحی شده نیازی به تنظیمات نهایی نداشته باشد. این کار معمولاً با تحلیل میدانی موجبر حاوی DR انجام می‌گیرد که مستلزم صرف زمان و هزینه‌های محاسباتی زیادی است [۴]. روش انگرال کانتور چندمدى یکی از روش‌های کارآمد در تحلیل مدارهای موجبری صفحه H است که استفاده از آن در مقایسه با سایر روش‌ها موجب صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای در زمان و سایر هزینه‌های محاسباتی می‌شود [۷-۵]. در

با بکارگیری شرط اتصال کوتاه روی زیر دهانه های پیرامون مدار موجبری، ماتریس ادمیتانس دهانه های موجبری،  $[Y]$ ، از روی ماتریس ادمیتانس کل،  $[Y_T]$ ، استخراج می گردد [۵].

با معرفی امپدانس موج در مدار  $TE_{10}$  برای موجبری با سطح مقطع  $: axb$

$$Z_0 = 120\pi \frac{b}{a} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}} = \frac{b}{a} Z_{TE_{10}} \quad (4)$$

ماتریس پراکندگی دهانه های موجبری را می توان به صورت معادله (۵) به دست آورد:

$$[S] = \left( Y_0 [E] + [Y] \right)^{-1} \left( Y_0 [E] - [Y] \right) \quad (5)$$

که در آن  $Y_0$  ادمیتانس موجبر در مدار  $TE_{10}$  بوده و  $[E]$  ماتریس واحد می باشد.

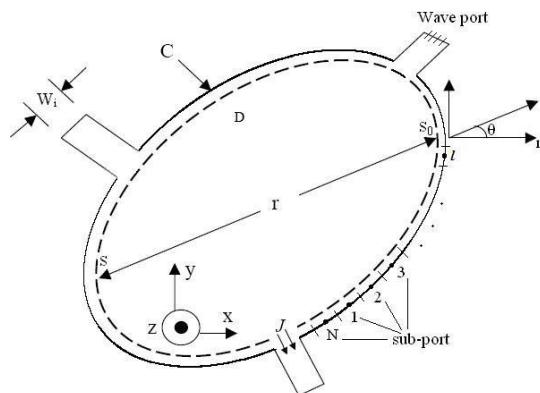
همانگونه که اشاره شد، در روش انتگرال کانتور تک مداری بخش های مستقیم موجبری در طرفین صفحه مرجع موردنیازند. این مسئله موجب بزرگ شدن ابعاد مدار و در نتیجه افزایش تعداد زیردهانه ها در مدار موجبر می گردد که در نهایت منجر به افزایش هزینه های محاسباتی خواهد شد. اما چنانچه فاصله بین ناپیوستگی های موجود در موجبر کم باشد، در نظر نگرفتن اثر مدهای مرتبه بالاتر منطقی به نظر نمی رسد. زیرا اندازه توان مختلط جاری درون مدهای میرا در اطراف ناپیوستگی قابل ملاحظه بوده و لازم است با محاسبه ماتریس پراکندگی کلی مدار، این اثر را تعیین کرد تا تحلیل مدار موجبری با دقت بالاتری صورت پذیرد. اینها دلایلی برای معرفی روش انتگرال کانتور "چند مداری" هستند. در این روش فرض می کنیم که علاوه بر مدار غالب  $TE_{10}$ ،  $TE_{M-1}$  مدار مرتبه بالاتر ( $TE_{20}$ ,  $TE_{30}$ , ...,  $TE_{M0}$ ) روی صفحات مرجع حضور دارند. با فرض اینکه محور  $x$  در امتداد صفحه مرجع باشد، وابستگی فضایی ولتاژ و چگالی جریان مدار  $n$  به صورت زیر خواهد بود:

$$\begin{aligned} v_n(x) &= V_{pn} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \\ j_n(x) &= J_{pn} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \end{aligned} \quad (6)$$

ولتاژ و جریان هر زیر دهانه روی صفحات مرجع را می توان به صورت ترکیب خطی از ولتاژ و جریان مدهای مختلف نوشت:

$$\begin{aligned} (V_s) &= \begin{pmatrix} V_{s_1} \\ \vdots \\ V_{s_M} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} V_1 + \dots + \alpha_{1M} V_M \\ \vdots \\ \alpha_{M1} V_1 + \dots + \alpha_{MM} V_M \end{pmatrix} = [\alpha](V) \\ (I_s) &= \begin{pmatrix} I_{s_1} \\ \vdots \\ I_{s_M} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_{11} I_1 + \dots + \beta_{1M} I_M \\ \vdots \\ \beta_{M1} I_1 + \dots + \beta_{MM} I_M \end{pmatrix} = [\beta](I) \end{aligned} \quad (7)$$

که در آن  $V_n$  و  $I_n$  ( $n=1, 2, \dots, M$ ) متوسط ولتاژ و جریان مدار  $TE_{n0}$  بوده و به صورت زیر تعریف می شوند:



شکل (۱): مدار صفحه ای و معرفی سمبل های استفاده شده در معادله (۱)  
Fig. (1): The planer circuit and the symbols used in equation (1)

در این معادله،  $H_0^{(2)}$  و  $H_1^{(2)}$  بترتیب توابع هنکل<sup>۲</sup> مرتبه صفر و مرتبه اول نوع دوم می باشند.  $k$  عدد موج،  $\omega$  فرکانس زاویه ای، و  $\mu$  نفوذ پذیری محیط می باشند. ضمناً  $a$  ارتفاع مدار است. برای انجام محاسبات عددی، مسیر پیرامون مدار به  $N$  زیردهانه با عرض دلخواه، اما بمراتب کوچکتر از طول موج، تقسیم شده و نقطه میانی هر زیر دهانه به عنوان نقطه نمونه برای محاسبه ولتاژ و جریان انتخاب می شود. در شکل (۱) قواعد کلی روش انتگرال کانتور روی یک مدار صفحه ای چند دهانه ای همراه با سمبولها و متغیرهای استفاده شده در معادله (۱) ارائه شده است.

نوشتن معادله (۱) در این نقاط نمونه، منجر به یک دستگاه  $N$  معادله ای می شود که نمایش ماتریسی آن معادله (۲) خواهد بود:  

$$[U]_{N \times N} (V_s)_N = [H]_{N \times N} (I_s)_N \quad (2)$$

از معادله (۲)، ماتریس ادمیتانس مدار  $N$  زیر دهانه ای به صورت زیر تعیین می شود:

$$[Y_T] = [H]^{-1} [U] \quad (3)$$

از روش انتگرال کانتور می توان برای تحلیل مدارهای موجبر مستطیلی، که قادر هرگونه تغییر در ارتفاع موجبر باشند، نیز استفاده کرد. در این مدارها، که به مدارهای صفحه  $H$ -موجبری معروفند، فقط مدهای  $TE_{n0}$  تحریک می شوند.

در روش انتگرال کانتور مرسوم که در برخی از کتب و مقالات به آن اشاره شده است، فقط اثر مدار غالب انتشاری ( $TE_{10}$ ) در نظر گرفته می شود [۸]. لذا برای تطبیق میدانهای درون مدار و مدار غالب موجبری روی صفحات مرجع، یعنی صفحه ای که اندازه گیری کمیات مورد نظر روی آن انجام می گیرد، از بخش های مستقیم موجبری با طول مناسب (حدوداً  $\lambda/2$ ) در دو طرف صفحات مرجع استفاده می شود تا بتوان اثر مدهای مرتبه بالاتر که در محل ناپیوستگی به وجود می آیند، صرف نظر کرد. به همین دلیل می توان آن را روش انتگرال کانتور "تک مداری" نیز نامید.

در این معادله بالانویس‌های  $p$ ,  $q$ ,  $sc$  و  $Post$  به ترتیب اشاره به زیردهانه‌های روی دهانه‌های موجبری  $p$  و  $q$ , مرز پیرامونی تیرک و بخش‌های اتصال کوتاه مدار دارد.

با روشی مشابه، رابطه ولتاژ- جریان در ناحیه II به دست می‌آید:

$$[U_{II}] \left( V_{II}^{Post} \right) = [H_{II}] \left( I_{II}^{Post} \right); \quad \text{on } C_2 \quad (12)$$

هدف اصلی در روش انتگرال کانتور، تعیین رابطه ولتاژ- جریان روی دهانه‌های موجبری  $p$  و  $q$  است. این هدف با اعمال شرایط مرزی روی فصل مشترک دو ناحیه و استفاده از معادلات (11) و (12) تحقق می‌یابد. در مرجع [7] معادلات نهایی ولتاژ- جریان به صورت زیر ارائه شده‌اند:

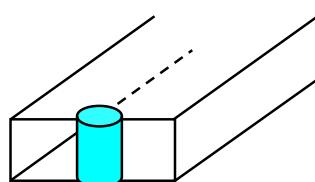
$$\begin{aligned} (I^p) &= \left\{ \left[ Y_I^{p,p} \right] - [C^p][A] \left[ Y_I^{Post,p} \right] \right\} (V^p) + \\ &\quad \left\{ \left[ Y_I^{p,q} \right] - [C^p][A] \left[ Y_I^{Post,q} \right] \right\} (V^q) \quad (13) \\ (I^q) &= \left\{ \left[ Y_I^{q,p} \right] - [C^q][A] \left[ Y_I^{Post,p} \right] \right\} (V^p) + \\ &\quad \left\{ \left[ Y_I^{q,q} \right] - [C^q][A] \left[ Y_I^{Post,q} \right] \right\} (V^q) \end{aligned}$$

با تعیین رابطه ولتاژ- جریان دهانه‌های موجبری، ماتریس پراکندگی مدار شناسایی خواهد شد.

#### ۴- نتایج شبیه سازی

به منظور ارزیابی نتایج روش انتگرال کانتور، در این بخش به بررسی چند مدار موجبری صفحه-H که در سایر مقالات به آنها اشاره شده است، می‌پردازیم.

در اولین مثال یک موجبر حاوی تیرک دی‌الکتریک تحلیل می‌شود. این مدار در شکل (۳) نشان داده شده است. یک تیرک استوانه‌ای دی‌الکتریک با شعاع  $a$  در مرکز سطح مقطع موجبر مستطیلی با پهنای  $a$  مستقر شده است. طول موج فضای آزاد ۰.۷ طول موج قطع TE<sub>10</sub> انتخاب شده است. شکل (۴) اندازه ضریب انعکاس را به صورت تابعی از ثابت دی‌الکتریک نشان داده و آن را با نتایج ارائه شده در مرجع [۴] مقایسه می‌کند. در روش انتگرال کانتور چندمدمی روی دهانه‌های موجبری ۱۵ مد در نظر گرفته شده است. ملاحظه می‌شود که روش انتگرال کانتور نیز مانند مرجع [۴] شرط تشددید را در ثابت دی‌الکتریک  $\epsilon = 112.5$  نشان می‌دهد.



شکل (۳): موجبر مستطیلی حاوی تیرک دی‌الکتریک

Fig. (3): The rectangular wave guide and a dielectric rod

$$V_n = \frac{1}{a/n} \int_0^{a/n} V_{pn} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx \quad (8)$$

$$I_n = \int_0^{a/n} J_{pn} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx$$

عناصر ماتریس‌های ضرایب  $[\alpha]$  و  $[\beta]$  نیز به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\alpha_{mn} = \frac{M}{n} \sin\left(\frac{2m-1}{2M} n\pi\right) \sin\left(\frac{n\pi}{2M}\right)$$

$$\beta_{mn} = \sin\left(\frac{2m-1}{2M} n\pi\right) \sin\left(\frac{n\pi}{2M}\right) \quad (9)$$

$$m, n = 1, 2, \dots, M$$

روی صفحات مرجع، مدهای مرتبه بالاتر غیر انتشاری بوده و فقط مد غالب TE<sub>n0</sub> انتشار می‌یابد. پس می‌توان فرض کرد که مدهای مرتبه بالاتر به امپدانس مشخصه راکتیو خود ختم شده‌اند [۸]:

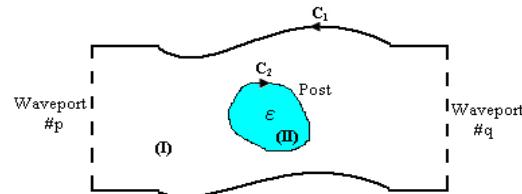
$$Z_{n0} = \frac{V_n}{I_n} = j120\pi \frac{b}{a/n} \frac{1}{\sqrt{\left(n\lambda/2a\right)^2 - 1}} \quad (10)$$

با روشی مشابه آنچه که در انتگرال کانتور تک مد عمل می‌شود، ماتریس پراکندگی کلی مدار<sup>۳</sup> (GSM) که شامل اثر مدهای مرتبه بالاتر است، به دست می‌آید. با تعیین شدن GSM، اطلاعات مورد نیاز شامل ضرایب انعکاس و انتقال مدهای مختلف از جمله مد غالب TE<sub>n0</sub> قابل محاسبه‌اند.

#### ۳- تحلیل محیط‌های چندگانه

محیط‌های چندگانه به محیط‌هایی گفته می‌شود که از چند محیط همگن متفاوت تشکیل شده باشند. در تحلیل محیط‌های چندگانه با روش‌های مزی مانند روش انتگرال کانتور لازم است برای هر زیر ناحیه همگن معادلاتی متناسب با شرایط آن ناحیه پایه‌ریزی کرد.

برای اجرای روش انتگرال کانتور، مدار موجبری صفحه-H شکل (۲) را که حاوی یک تیرک دی‌الکتریک است، در نظر بگیرید. این مدار از دو ناحیه همگن متفاوت تشکیل شده است. ابتدا هر دهانه موجبری را به  $m$  و مرز پیرامونی تیرک را به  $M$  زیردهانه تقسیم می‌کنیم.

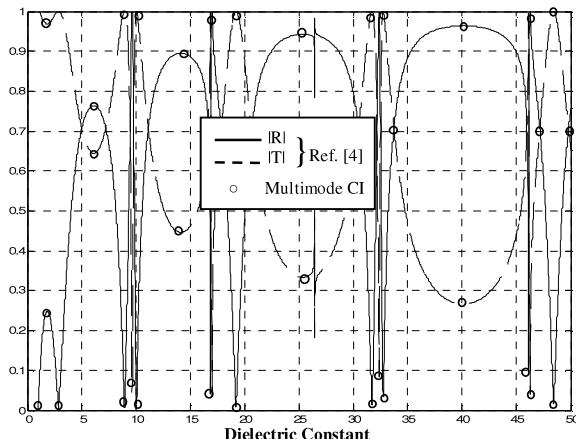


شکل (۲): نمای فوقانی مدار موجبری صفحه-H حاوی یک تیرک دی‌الکتریک

Fig. (2): The upper view of H-plan wave guide circuit having a dielectric rod

بازنویسی معادله (۳) برای ناحیه I نتیجه می‌دهد که:

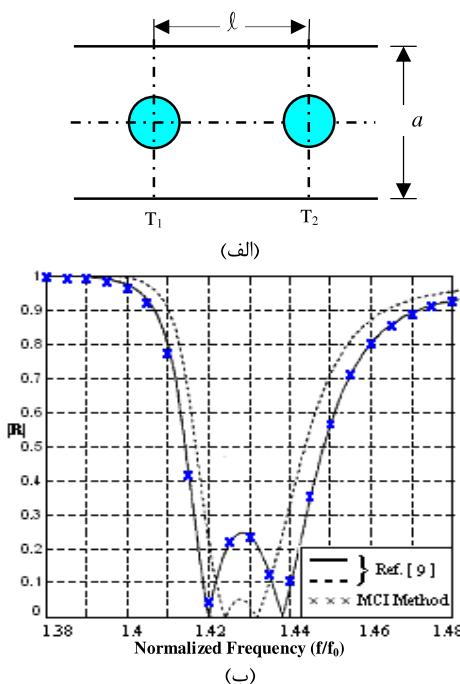
$$\begin{bmatrix} (V^p) \\ (V^q) \\ (V_I^{Post}) \\ (0) \end{bmatrix} = [H_I] \begin{bmatrix} (I^p) \\ (I^q) \\ (I_I^{Post}) \\ (I^{sc}) \end{bmatrix}; \quad \text{on } C_1 + C_2 \quad (11)$$



شکل (۶): دامنه ضرایب انعکاس و انتقال تیرک عایق بر حسب ثابت دی الکتریک بازی  $\lambda_o/\lambda_{c_{10}} = 0.7$  و  $r/a = 0.25$

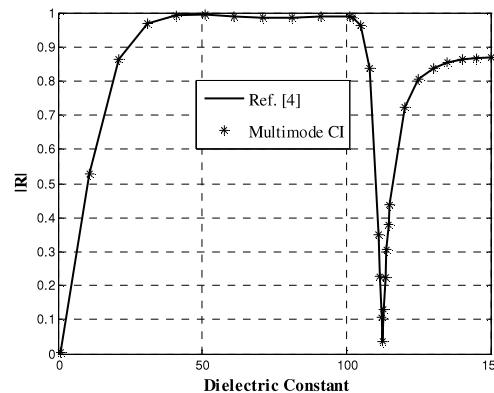
Fig. (6): The amplitude of reflection coefficient and transport of dielectric rod as a function of dielectric constant for  $r/a = 0.25$  and  $\lambda_o/\lambda_{c_{10}} = 0.7$

مثال بعدی، یک مدار موجبری حاوی دو تیرک دی الکتریک استوانه‌ای می‌باشد. تیرک‌ها دارای شعاع نسبی  $r/a = 0.05$  و ثابت دی الکتریک  $\epsilon_r = 112.5$  بوده و در وسط موجبر قرار گرفته‌اند. در شکل (۷-الف) نمای فوقانی این مدار و در شکل (۷-ب) دامنه ضریب انعکاس بر حسب فرکانس نرمالیزه  $f/f_{c_{10}}$  نشان داده شده‌اند.



شکل (۷): دامنه ضریب انعکاس در موجبر مستطیلی حاوی دو تیرک دی الکتریک استوانه‌ای ( $\epsilon_r = 112.5$ )

Fig. (7): The amplitude of reflection coefficient in a rectangular wave guide having two cylindrical dielectric rod ( $\epsilon_r=112.5$ )

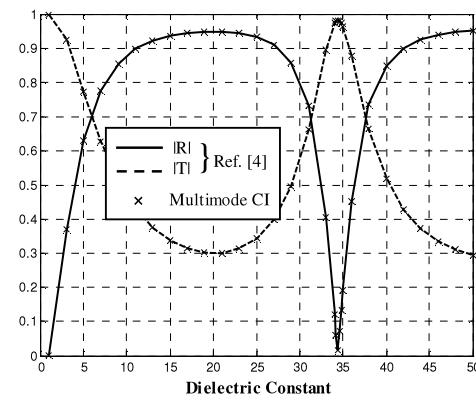


شکل (۴): دامنه ضریب انعکاس به صورت تابعی از ثابت دی الکتریک بازی  $\lambda_o/\lambda_{c_{10}} = 0.7$  و  $r/a = 0.05$

Fig. (4): The amplitude of reflection coefficient in term of dielectric constants for  $r/a = 0.05$  and  $\lambda_o/\lambda_{c_{10}} = 0.7$

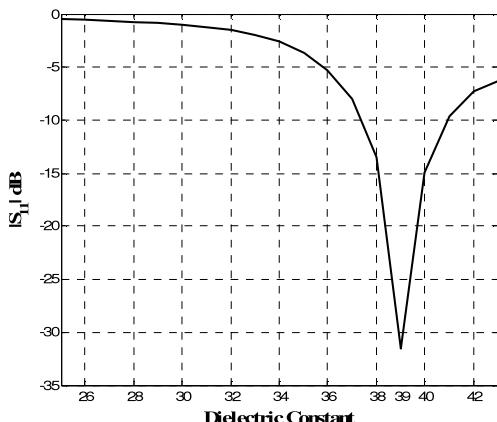
شکل (۵) نتایج به دست آمده با روش انتگرال کانتور چندمدمی را با احتساب ۱۳ مد برای اندازه ضرایب انعکاس و انتقال مدار موجبری شکل (۳) بازی نسبت طول موج  $|R|$  و  $\lambda_o/\lambda_{c_{10}} = 0.799$  نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که تغییرات  $|R|$  و  $|T|$  با ثابت دی الکتریک عکس یکدیگر است. در طراحی فیلتر، لازم است ثابت دی الکتریک تیغه برابر  $\epsilon_r = 34.4$  انتخاب شود.

شکل (۶) تغییرات دامنه ضرایب انعکاس و انتقال را بر حسب ثابت دی الکتریک برای تیرکی با  $r/a = 0.25$  و  $\lambda_o/\lambda_{c_{10}} = 0.6366$  نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که تعداد زیادی ماکریزم و مینیمم وجود دارد که این موجب آزادی عمل در انتخاب دی الکتریک می‌شود.

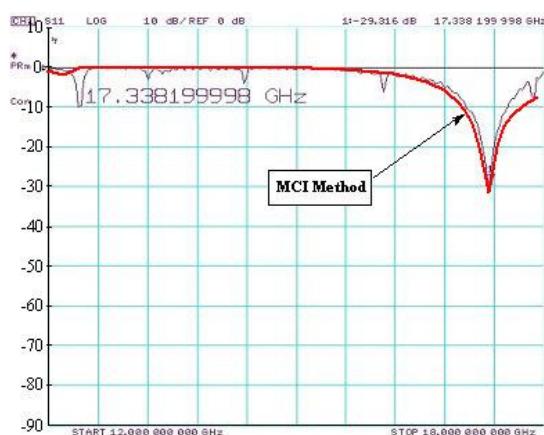


شکل (۵): ضرایب انعکاس و انتقال به صورت تابعی از ثابت دی الکتریک به ازای  $\lambda_o/\lambda_{c_{10}} = 0.799$  و  $r/a = 0.1$

Fig. (5): The reflection and transmission coefficient as a function of dielectric constant for  $r/a = 0.1$  and  $\lambda_o/\lambda_{c_{10}} = 0.799$



شكل (١٠): منحنى تغيرات  $S_{11}$  بحسب ثابت دي الكتريلك DR  
 Fig. (10): The variations of  $S_{11}$  as a function of dielectric constant DR



شکل (۱۱): مقایسه نتایج انگرال کانتور چندمی با نتایج اندازه‌گیری شده برای DR‌های استفاده شده در LNB آنتن ماهواره

Fig. (11): The comparison of the multimode countour integral with experimental results for DRs used in satellites LNB antenna

۵- نتیجہ گیری

در این مقاله از روش انتگرال کانتور چندمدمی برای شناسایی مشخصات DRها مانند فرکانس تشیدید و در مسئله معکوس تعیین ثابت دی الکتریک استفاده شد. ویژگی بارز این روش، توجه به مدهای مرتبه بالاتر غیرانتشاری است که در نزدیکی ناپیوستگی حضور داشته و از انرژی بالایی برخوردارند. اعتبار و دقت این روش در مقایسه با سایر روشها ارزیابی و تأیید شد. تلاش برای تعیین تعداد مناسب مدد روی دهانه های موجبری در روش انتگرال کانتور چندمدمی به کارهای بعدی مهکم می گردد.

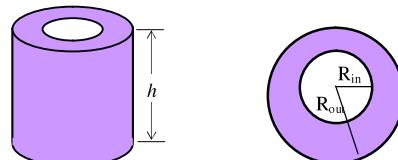
## پی نوشت:

- 1- Dielectric Resonator
  - 2- Hankel Function
  - 3- Generalized Scattering Matrix
  - 4- Low Noise Block converter

برای تحلیل این مدار، تعداد ۱۵ مد استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصل از روش انتگرال کانتور چندمدى با نتایج ارائه شده در مرجع [۹]، حاکی از دقت بالاي روش انتگرال کانتور است.

در آخرين مثال، اقدام به تعیین ثابت دى الکتریک DR های مورد استفاده در LNB<sup>۴</sup> انتنهای ماهواره‌ای کرده‌ایم. شکل (۸) شماتیک لکی این تشیدیدگرها را نشان می‌دهد. اين DR ها به شکل واشر بوده و دارای ابعاد  $R_{in} = 0.99$ ,  $R_{out} = 2.418$ ,  $h = 2.1$  mm می‌باشند.

از آنجائی که اطلاعات دقیقی در مورد ثابت دى الکتریک این تشیدیدگرها در دسترس نبود، بر اساس حدس‌های موجود در خصوص حدود تغیری در دسترس نبود، یك تیرک استوانه‌ای به ارتفاع موجبر ۶۲ mm و عرض ۷.۹ mm، پاسخ فرکانسی مدار برای پارامتر تولید و در مرکز موجبر قرار داده شد. پاسخ فرکانسی مدار با  $S_{11}$  با کمک دستگاه تحلیل گر شبکه در باند ku تعیین گردید. اين پاسخ در شکل (۹) نشان داده شده است. همانگونه که در اين شکل واضح است کمترین مقدار  $S_{11}$  در فرکانس ۱۷.۳۳۸ GHz رخ می‌دهد. با شیوه سازی مدار و استفاده از روش انتگرال کانتور چندمدى منحنی تغییرات  $S_{11}$  بر حسب ثابت دى الکتریک در فرکانس ۰ ترسیم گردد. اين نمودار در شکل (۱۰) ترسیم شده است. از اين نمودار ثابت دى الکتریک  $39 \pm 4$  تعیین شد. به منظور اطمینان از نتایج شبیه سازی، پاسخ فرکانسی مدار با نتایج عملی در شکل (۱۱) مقایسه شده‌اند. اين مقایسه دقت روش انتگرال کانتور چندمدى عددی را تأیید می‌کند.



شکل (۸): شکل ظاهری DR مورد استفاده در LNB آنتن ماهواره  
Fig. (8): The appearance of DR used in satellite antenna



شکل (۹): اندازه‌گیری پارامتر  $S_{11}$  برای قطعه دی‌کلریک مجهول

Fig. (9): The measurement of  $S_{11}$  parameter for an unknown dielectric

### مراجع

- [1] I.C. Hunter, "Theory and design of microwave filters", IEE, 2001.
- [2] C. Bachiller, et al., "Efficient CAD tool of direct-coupled-cavities filters with dielectric resonators", IEEE AP-S, Vol.1B, pp.578-581, 2005.
- [3] C. Bachiller, et al., "CAD of evanescent mode waveguide filters with circular dielectric resonators", IEEE AP-S, pp.1567-1570, 2006.
- [4] J.N. Sahalos, E. Vafiadis, "On the narrow-band microwave filter design using a dielectric rod", IEEE Trans. Microw. Theo. Tech., Vol.33, No.11, pp.1165-1171, Nov. 1985.
- [5] A. Hashemi, A. Banai, "Analysis of waveguide filters with dielectric resonators using multimode contour integral method", APMC/IEEE MTT-S, pp.2083-2086, 2007.
- [6] A. Hashemi, A. Banai, "Analysis of H-plane waveguide discontinuities using hybrid multimode contour integral and mode matching techniques", SBMO/IEEE MTT-S (IMOC2007), pp.840-843, 2007.
- [7] A. Banai, A. Hashemi, "A hybrid multimode contour integral method for analysis of the H-plane waveguide discontinuities", Progress in electromagnetics research, PIER 81, pp.167-182, 2008.
- [8] T. Okoshi, "Planar circuits for microwaves and lightwaves", Springer-Verlag, 1985.
- [9] K. Ise, M. Koshiba, "Equivalent circuits for dielectric posts in a rectangular waveguide", IEEE Trans. Micro. Theo. Tech., Vol.37, No.11, pp.1823-1825, Nov. 1989.